

## \* 主要用途：

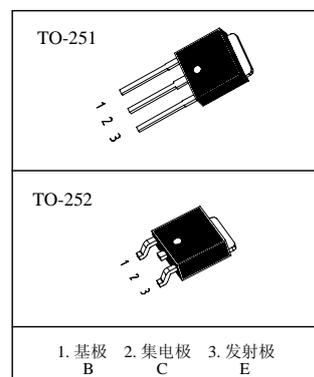
电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

## \* 主要特点：

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

## \* 封装形式：

TO-251 / TO-252



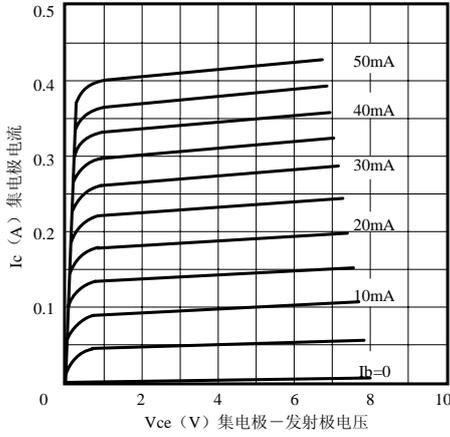
极限值：(  $T_c=25\text{ }^\circ\text{C}$  )

参数名称	符号	额定值	单位
集电极—发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$\geq 400$	V
集电极—基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$\geq 600$	V
发射极—基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$\geq 9$	V
最大集电极直流电流	$I_{cm}$	1.2	A
最大耗散功率	$P_{cm}$	20	W
最高结温	$T_{jm}$	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ\text{C}$

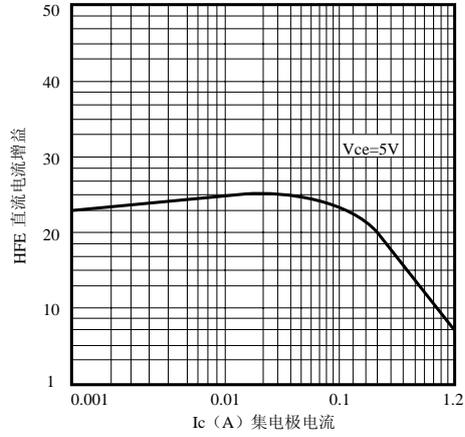
电特性：(  $T_c=25\text{ }^\circ\text{C}$  )

参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
			最小值	最大值	
集电极—发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=1\text{mA}; I_B=0$	400		V
集电极—基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=1\text{mA}; I_E=0$	600		V
发射极—基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=1\text{mA}; I_C=0$	9		V
集电极—发射极反向漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=350\text{V}; I_B=0$		20	$\mu\text{A}$
集电极—基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=550\text{V}; I_E=0$		10	$\mu\text{A}$
发射极—基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7\text{V}; I_C=0$		10	$\mu\text{A}$
共发射极直流电流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=5\text{V}; I_C=0.2\text{A}$	10	35	
集电极—发射极饱和压降	$V_{CE}(\text{sat})$	$I_C=0.5\text{A}; I_B=0.2\text{A}$		0.6	V
下降时间	$t_f$	$I_C=1\text{A}; I_{B1}=I_{B2}=0.2\text{A}; V_{CE}=300\text{V}$		0.3	$\mu\text{s}$
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}; I_C=0.1\text{A}; f=1\text{MHz}$		8	MHz

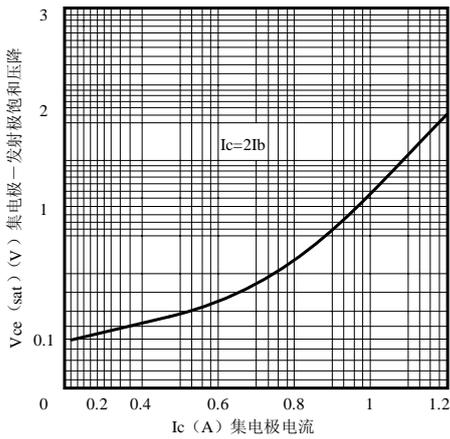
静态输出特性



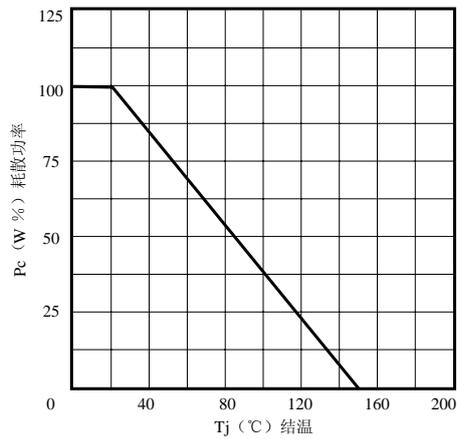
HFE 直流电流增益 -  $I_c$  集电极电流



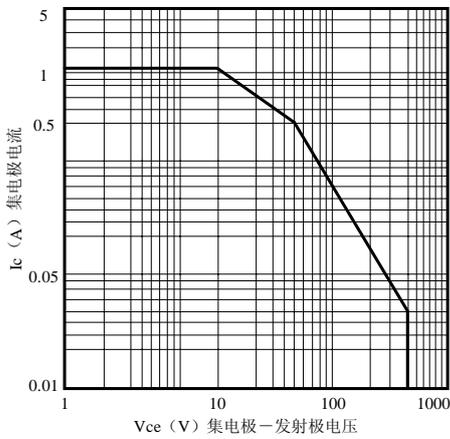
$V_{ce(sat)}$  集电极-发射极饱和电压降 -  $I_c$  集电极电流



$P_c$  耗散功率 -  $T_j$  结温



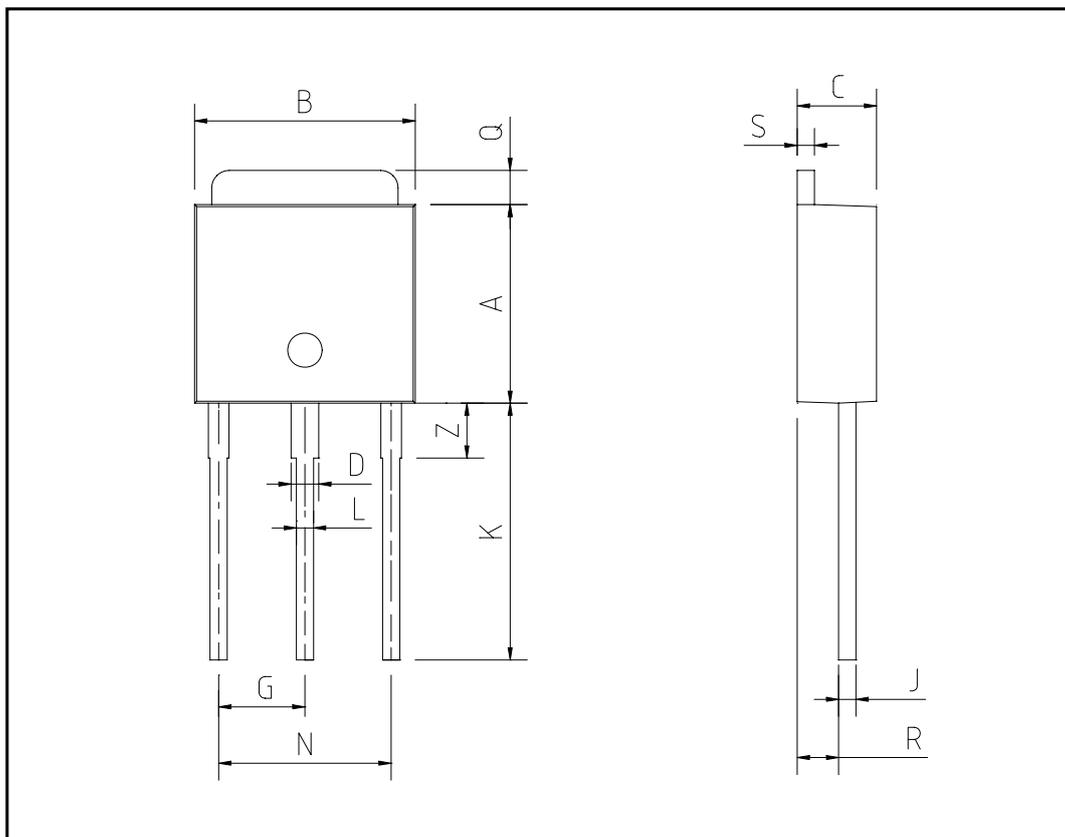
SOA (DC) 安全工作区



# TO - 251 外形尺寸图

单位: mm

www.DataSheet4U.com



符 号	最小值	典型值	最大值
A	6.11	6.13	6.15
B	6.41	6.44	6.47
C	2.27	2.30	2.33
D	0.70	0.75	0.80
G		2.26	
J	0.48	0.51	0.54
K	7.45	7.50	7.55
L	0.52	0.55	0.58
N	4.49	4.52	4.55
Q	0.85	0.88	0.91
R	1.09	1.125	1.16
S	0.49	0.52	0.55
Z	1.86	1.88	1.90